

**Выписка из протокола № 10**  
**от 30 октября 2015 г.**  
**заседания диссертационного совета Д 002.231.01 на базе ИРЭ им.**  
**В.А.Котельникова РАН**

**Присутствовали:** 23 члена совета из 25, приглашенные специалисты.

**Председатель:** д.ф-м.н., член-корр. РАН С.А.Никитов

**Ученый секретарь:** д.ф-м.н., доцент И.Е.Кузнецова

На заседании присутствовали следующие члены совета:

№ пп	Фамилия, и.о., инициалы	Ученая степень, шифр специальности
1.	Гуляев Ю.В.	д.ф-м.н.,01.04.07
2.	Никитов С.А.	д.ф-м.н.,01.04.11
3.	Кузнецова И. Е.	д.ф-м.н.,01.04.10
4.	Анисимкин В.И.	д.ф-м.н.,01.04.10
5.	Артеменко С.Н.	д.ф-м.н.,01.04.07
6.	Волков В.А.	д.ф-м.н.,01.04.10
7.	Губанков В.Н.	д.ф-м.н.,01.04.07
8.	Демидов В.В.	д.ф-м.н.,01.04.11
9.	Дмитриев А.С.	д.ф-м.н.,01.04.10
10.	Зайцев-Зотов С.В.	д.ф-м.н.,01.04.07
11..	Каган М.С.	д.ф-м.н., 01.04.10
12.	Котельников И.Н.	д.ф-м.н.,01.04.10
13.	Любченко В.Е.	д.ф-м.н.,01.04.10
14.	Нагаев К.Э.	д.ф-м.н.,01.04.07
15.	Носов Ю.Р.	д.т.н. , 01.04.10
16.	Овсянников Г.А.	д.ф-м.н.,01.04.11
17.	Ползикова Н.И.	д.ф-м.н.,01.04.11
18.	Попков А.Ф.	д.ф-м.н.,01.04.11
19.	Рязанов В.В.	д.ф-м.н.,01.04.07
20.	Сабликов В.А.	д.ф-м.н.,01.04.10
21.	Синченко А.А.	д.ф-м.н.,01.04.07
22.	Фетисов Ю.К.	д.ф-м.н.,01.04.11
23.	Шавров В.Г.	д.ф-м.н.,01.04.11

**Повестка дня:**

1.Защита диссертации **Папроцкого** Станислава Константиновича на тему: «Транспортные явления в объемном Ge и наноструктурах на основе Si, GaAs и InAs, перспективных для генерации ТГц излучения» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников».

**Научный руководитель:** Каган Мирон Соломонович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией № 172 «Электронные процессы в полупроводниковых материалах» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук (ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН.).

§ 1.

**Слушали:**

Защиту диссертации **Папроцкого** Станислава Константиновича на тему: «Транспортные явления в объемном Ge и наноструктурах на основе Si, GaAs и InAs, перспективных для генерации ТГц излучения» на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников».

Диссертация выполнена в лаборатории «Электронных процессов в полупроводниковых материалах» (лаб.№ 172) Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова Российской академии наук.

### Официальные оппоненты

- **Мурзин** Владимир Николаевич, доктор физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник Отделения физики твердого тела ФГБУН Физического института им. П.Н.Лебедева Российской академии наук

- **Шаповал** Сергей Юрьевич, кандидат технических наук, старший научный сотрудник, зав.лаб. Эпитаксиальных микро- и наноструктур ФГБУН Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов Российской академии наук, дали положительные отзывы о диссертации.

### Ведущая организация:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова» (физический факультет) (Москва), дала положительный отзыв.

В дискуссии приняли участие: Носов Юрий Романович, доктор технических наук, профессор, нач.лаб. ПАО «НПП»Сапфир»; Гуляев Юрий Васильевич, доктор физико-математических наук, профессор, академик, научный руководитель ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; Анисимкин Владимир Иванович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник лаб. электронных процессов в полупроводниковых материалах ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; Гергель Виктор Александрович, доктор физико-математических наук, профессор, зав. лаб. микро- и нанозлектроники ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН; Никитов Сергей Аполлонович, доктор физико-математических наук, профессор, член-корр. РАН, директор ИРЭ им. В.А.Котельникова РАН.

### Постановили:

1. На основании результатов тайного голосования членов диссертационного совета: **за -22; против - нет; недействительных бюллетеней - 1** (в голосовании приняли участие 23 члена диссертационного совета из **25** человек, входящих в его состав, в т.ч. 9 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации) считать, что диссертация **Папроцкого** Станислава Константиновича соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук (п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней...» утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. N 842), и присудить автору ученую степень кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 «Физика полупроводников».

2. На основании результатов открытого голосования (за – 23; против – нет) принять текст Заключения по диссертации С.К.Папроцкого в соответствии с требованиями п. 32 Положения о присуждении ученых степеней.

Выписка из протокола № 10 от 30.10.2015 г. верна:

Ученый секретарь диссертационного совета  
доктор физ-мат.наук, доцент



И.Е.Кузнецова